

第20回 大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所シンポジウム
原子・分子レベルでの材料創製とキャラクタリゼーション
「スピントロニクスマテリアルの新しい展開」

主催：大阪電気通信大学 エレクトロニクス基礎研究所

協賛：応用物理学会関西支部、日本磁気学会、日本表面科学会関西支部、日本真空協会関西支部
(依頼中を含む)

日時：2013年1月11日(金)

場所：大阪電気通信大学 駅前キャンパス 1階 101室

寝屋川市早子町 12-16 電話 072-824-8900

京阪電鉄 寝屋川市駅より徒歩3分

<http://www.osakac.ac.jp/institution/access.html> 参照

参加費：聴講 無料、資料集代 500円、懇親会参加費 2,000円

URL：<http://www.feri.osakac.ac.jp/>

本シンポジウムは原子・分子レベルで制御した材料創製とキャラクタリゼーションに関する最新の研究成果を議論することにより、当該分野の研究の一層の発展を促すことを目的として毎年開催されております。

本年は第20回として「スピントロニクスマテリアルの新しい展開」を主題としてシンポジウムを開催いたします。スピントロニクスは、エレクトロニクスの次世代を担う技術として近年注目を浴びており、研究開発が盛んにおこなわれています。本シンポジウムでは、スピントロニクスマテリアルにスポットをあて、その現状と将来展望を議論します。

多数のご参加をいただき、活発な議論を行っていただくことを期待しております。

1. 10:00~10:05 主催者挨拶
エレクトロニクス基礎研究所所長 越川 孝範
2. 10:05~10:50 『超高輝度・高偏極スピン偏極低エネルギー電子顕微鏡の開発とスピントロニクス薄膜材料への応用』
大阪電気通信大学 越川 孝範
3. 10:50~11:35 『計算機マテリアルデザイン先端研究事例ー表面スピントロニクスー』
大阪大学 笠井 秀明
4. 11:35~12:20 『非磁性物質の表面でのスピン分裂とスピン輸送』
東京大学 長谷川 修司
- 12:20~13:45 <<昼食・休憩>>
5. 13:45~14:30 『Domain Imaging at Multiferroic Perovskite Surfaces by Laser-induced Threshold Photoemission Microscopy』
Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg Wolf Widdra
6. 14:30~15:15 『スキルミオン生成と動的観察』
理研 于 秀珍
- 15:15~15:30 <<休憩>>
7. 15:30~16:15 『スピン軌道相互作用から生じるスピン起電力とモノポール』

8. 16:15~17:00 『金属ナノ構造におけるスピン流誘起物性』

東京大学 大谷 義近

17:15~19:15 懇親会 (駅前キャンパス 2階 207 室)

問合せ先

大阪電気通信大学

越川 孝範 Tel:072-824-1131(ext.2582)、E-mail: kosikawa@isc.osakac.ac.jp

安江 常夫 Tel:072-824-1131(ext.2582)、E-mail: yasue@isc.osakac.ac.jp

参加申し込み

所属、氏名、資料集の要否、懇親会への参加の有無を下記までご連絡ください。

大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所事務室 佐々木 政美

〒572-8530 寝屋川市初町18-8

Tel: 072-824-1131(ext.2588) Fax: 072-820-9010

E-mail: feri@isc.osakac.ac.jp